

本文目录

- [砷化镓高倍聚光太阳能电池优缺点？](#)
- [太阳能蓄电池哪种好？](#)
- [一千瓦太阳能要多少钱？](#)
- [光电转换率最高的光伏板？](#)
- [薄膜太阳能电池污染有哪些？](#)
- [半导体用硅和太阳能电池用硅区别？](#)
- [太阳能蓄电池使用寿命？](#)
- [砷化镓的相对分子质量？](#)

砷化镓高倍聚光太阳能电池优缺点？

砷化镓高倍聚光太阳能电池优点：耐温性好萊垍頭條

砷化镓电池的耐温性要好于硅光电池，有实验数据表明，砷化镓电池在250°C的条件下仍可以正常工作，这对于实时有电流充放并产生大量热能的汽车行业应该能增加不少稳定性。萊垍頭條

砷化镓高倍聚光太阳能电池缺点：成本高昂垍頭條萊

砷化镓电池由于在相对高温情况下的优越性能，一出现就饱受关注，包括很多航空航天机器都在使用砷化镓材料的太阳能发电系统，不过这种电池的成本也是比硅光电池要高出很多的。萊垰頭條

太阳能蓄电池哪种好？

砷化镓太阳能蓄电池最好萊垰頭條

太阳能电池分硅晶体电池，和其他半导体电池。硅太阳由于成本低，所以普及率高，硅太阳能电池还分单晶硅、多晶硅和非晶硅，转换效率以单晶硅最好，但是价格最贵。它的最好转换效率在22%左右。萊垰頭條

还有一种砷化镓太阳能电池，它的转换效率更高，可以达到30%以上，一般只做为空间卫星使用。萊垰頭條

一千瓦太阳能要多少钱？

一千瓦晶硅太阳能电池在7000-10000之间，铜铟镓硒薄膜太阳能电池8000-12000之间，砷化镓薄膜太阳能电池12000左右。价格主要因光转化效率、生产成本、产量等因素影响，中益兴业薄膜太阳能电池重量轻、厚度薄、可弯曲、长度可定制、无热斑效应、弱光可发电等特点相比晶硅太阳能电池在应用领域及市场竞争力上有优势，目前价格受产能影响的确比晶硅太阳能电池稍贵些。萊垰頭條

光电转换率最高的光伏板？

多结级联砷化镓太阳能电池是目前世界上承认的光电转化效率最高的太阳能电池。萊垰頭條

在高聚光的条件下，这类电池的光电转化效率已突破 40.0%。萊垰頭條

目前高效多结砷化镓太阳能电池已经广泛应用于航天航空领域，在空间环境中，砷化镓太阳能电池的抗辐照能力也远大于硅太阳能电池。

砷化镓材料是直接跃迁型，硅材料是间接跃迁型，而且砷化镓太阳能电池的带隙与太阳光谱的匹配程度比硅太阳能电池的匹配程度要高。萊垰頭條

薄膜太阳能电池污染有哪些？

薄膜太阳能电池有砷化镓、铜铟镓硒等很多种，单铜铟镓硒也有很大类型。而各个

生产流程及工艺有所不同，所以有些的确会产生污染情况，但相比其他太阳能电池生产环节所产生的污染要小很多。先了解一下薄膜太阳能电池的优缺点。柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件在各项指标都有优势，具体分析如下：萊垵頭條

- 1、成本低，具有更低生产成本，不受硅原料短缺瓶颈的限制；頭條萊垵
- 2、生产过程能耗低、无污染；萊垵頭條
- 3、组件绿色环保：不含有毒元素；萊垵頭條
- 4、弱光发电性能更好：非晶硅电池在低光照射条件下，如阳光不太强的早晨、傍晚、阴天以及临近建筑物遮挡，也能有稳定电力输出，满足阴雨天正常供应需求，散射光接受率高，利用率高、适合用于各种地区；萊垵頭條
- 5、热稳定性好：在相同的环境条件下，非晶硅电池具有较低的温度系数和优良的伏安特性；萊垵頭條
- 6、在较高的环境温度下，非晶硅太阳能电池组件表现出更优异的发电性能。当太阳能电池工作温度高于标准测试温度25℃时，其最佳输出功率会有所下降，但非晶硅太阳能电池受温度的影响比晶体硅太阳能电池要小得多；萊垵頭條
- 7、发电量更高：科学数据表明，在相同环境条件下，非晶硅太阳电池的每千瓦年发电量要比单晶硅高15%左右；萊垵頭條
- 8、抗遮挡性能好：在有少量遮挡情况下，发电量要高出晶硅40%~50%，易于应用在复杂环境；萊垵頭條
- 9、更适应光伏建筑一体化：使用大面积玻璃为衬底，同时可制作成不同透光率、不同颜色的透光组件，外形美观、无光污染。 條萊垵頭

半导体用硅和太阳能电池用硅区别？

1半导体硅：;是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的硅材料，主要包括硅粉、硅棒、硅片、籽晶、单晶硅、多晶硅、半导体晶体管、单晶硅棒、单晶硅片、单晶硅切磨片、单晶硅抛光片、单晶硅外延片、单晶硅太阳能电池板、单晶硅芯片、砷化镓、单晶锗、太阳能电池圆片、方片、二极管、三级管、硅堆、复合半导体器件、微波射频器件、可控硅器件、高频管、低频管、功率管、MOS管、集成电路萊垵頭條

2太阳能级硅材料是纯度为6个9以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999%以上的硅材料。萊垍頭條

3ic级硅啊，我不知道！！，你干什么的？萊垍頭條

太阳能蓄电池使用寿命？

使用寿命是20年左右。太阳电池是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体硅为例描述光发电过程。萊垍頭條

砷化镓的相对分子质量？

分子量:144.64。萊垍頭條

砷化镓，化学式GaAs。分子量144.64。深灰色立方晶体。比重5.4。熔点1,238°C。属Ⅲ、V族化合物半导体，禁带宽度和电子迁移率比元素半导体锗及硅的大，制成的器件有较好的耐高温特性及频率特性；发光特性好及光电转换率高。高于600°C时被空气氧化，无氧化剂存在时仅被酸缓慢地侵蚀。由镓和砷在高温及一定的砷蒸气压下合成。砷化镓可用于制作变容二极管、场效应管、发光二极管，以及太阳能电池、微波发生器和半导体激光器等。萊垍頭條